



**Toshiba Memory Europe dévoile les premières mémoires Flash embarquées UFS Version 3.0 du marché**

*Permet d'obtenir les débits supérieurs nécessaires à l'évolution continue des smartphones, tablettes, et autres dispositifs de réalité augmentée/virtuelle*

**Düsseldorf, Allemagne, 23 janvier 2019** - Toshiba Memory Europe (TME) a commencé à échantillonner la version 128 Go<sup>[1]</sup> de ses mémoires Flash embarquées UFS (Universal Flash Storage) version 3.0 La nouvelle gamme utilise la mémoire Flash 3D de pointe BiCS FLASH™ à 96 couches Toshiba, et existe en trois capacités : 128 Go, 256 Go et 512 Go<sup>[2]</sup>. Grâce à ses vitesses de lecture/écriture élevées et à sa faible consommation, ces nouveaux dispositifs conviennent parfaitement aux applications telles que les appareils mobiles, les smartphones, les tablettes et autres systèmes de réalité augmentée/virtuelle.

Les consommateurs continuent d'exiger plus de performances de leurs appareils, ainsi qu'une meilleure expérience utilisateur, et la norme UFS progresse en permanence pour répondre à ce

besoin d'évolution. Grâce à son interface série, l'UFS supporte le full-duplex, ce qui permet à la fois la lecture et l'écriture simultanée, entre le processeur hôte et le périphérique UFS. Avec l'introduction de l'UFS 3.0, JEDEC, leader mondial du développement de normes pour l'industrie microélectronique, a amélioré les versions précédentes de la norme UFS pour aider les concepteurs de produits à apporter des améliorations significatives aux appareils mobiles et aux applications associées.

Ces nouveaux dispositifs intègrent une mémoire Flash 3D BiCS FLASH™ à 96 couches et un contrôleur, dans un boîtier JEDEC standard de 11,5 x 13 mm. Le contrôleur assure la correction d'erreur, le nivellement d'usure, la conversion logique-physique d'adresse et la gestion des blocs défectueux, ce qui simplifie le développement système.

Les trois dispositifs sont compatibles avec la norme JEDEC UFS Version 3.0, y compris HS-GEAR4, dont la vitesse théorique d'interface peut atteindre 11,6 Gbits/s par voie (x 2 voies = 23,2 Gbits/s), tout en prenant en charge les fonctions qui suppriment les augmentations de consommation électrique. Les vitesses de lecture et d'écriture séquentielles du dispositif 512 Go sont en hausse de 70% et 80% respectivement, par rapport aux dispositifs Toshiba 256 Go de génération précédente.

Toshiba a été la première entreprise à introduire des dispositifs UFS et en livre depuis 2013. L'introduction de ces dispositifs UFS Version 3.0 maintient la position de leader de Toshiba en matière de stockage pour appareils mobiles de nouvelle génération, position que l'entreprise compte bien conserver en faisant progresser la technologie.

Des échantillons de ces nouveaux dispositifs seront exposés sur le stand Toshiba (Hall 3A - 424) au salon Embedded World 2019 (du 26 au 28 février à Nuremberg en Allemagne).

###

**Notes :**

[1] Les livraisons d'échantillons du dispositif 128 Go démarrent aujourd'hui et le reste de la gamme suivra progressivement après le mois de mars. Les spécifications des échantillons peuvent différer de celles des produits commerciaux.

[2] La densité du produit est déterminée selon la densité des puces mémoire utilisées, et non selon la capacité mémoire disponible pour le stockage de données par l'utilisateur final. La capacité utilisable par l'utilisateur est moindre, du fait de zones de données supplémentaires, du formatage, d'éventuels blocs défectueux, et d'autres contraintes, et peut également varier selon le dispositif hôte et l'application. Pour plus de détails, merci de vous reporter aux spécifications produit applicables. La définition de 1 Go = 2<sup>30</sup> octets = 1 073 741 824 octets.

**A propos de Toshiba Electronics Europe**

Toshiba Memory Europe est la branche européenne de Toshiba Memory Corporation. La société propose une large gamme de mémoires flash haut-de-gamme, notamment des cartes SD, des clés USB, et des composants mémoire embarqués, en

plus de disques SSD (Solid State Disk, ou disque à semiconducteurs). Notre société dispose de bureaux en Allemagne, en France, en Espagne, en Suède et au Royaume-Uni. Le président de la société est Masaru Takeuchi.

Pour plus d'informations sur notre gamme complète de mémoires et produits SSD, merci de visiter <https://www.toshiba-memory.com/>

**Contact pour publication :**

Toshiba Memory Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Allemagne

Tél : +49 (0)211 5296-0 Fax : +49 (0) 211 5296 79197

E-mail : [support@toshiba-memory.com](mailto:support@toshiba-memory.com)

**Contact Presse :**

Philipp Schiwiek, Toshiba Memory Europe GmbH

Tél : +49 (0) 211 36877 319

E-mail : [pschiwek@toshiba-tme.eu](mailto:pschiwek@toshiba-tme.eu)

**Publié par :**

Birgit Schöniger, Publitek

Tél : +44 (0) 20 8429 6554

E-mail : [birgit.schoeniger@publitek.com](mailto:birgit.schoeniger@publitek.com)

Web : [www.publitek.com](http://www.publitek.com)

**Réf : TME017A\_FRE**